

Übersicht Ge-Dioden

Typ	Anwendung			Grenzwerte				
	Universal- diode	Schaltdiode	Photodiode	U_R/V	U_{RM}/V	I_F/mA (I_M/mA)	I_{FM}/mA	P_{tot}/mW
GA 100	■			20	26	20	45	
GA 101	■			40	50	15	45	
GA 102	■			60	70	12	45	
GA 103	■			80	90	10	45	
GA 104	■			110	115	10	45	
GA 105	■			20	26	20	45	
GA 106		■		25	35	20	30	
GA 107		■		60	90	20	150	
GA 108	■			80	90	20	45	
2 GA 109	■			40	50	15	45	
2 GA 113	■			25	35		30	
4 GA 114	■			25	35		30	
0.4 A 657	■			40	50	15	45	
GAY 60		■		20	25	75	225	80
GAY 61		■		20	25	100	300	80
GAY 62		■		20	25	100	300	80
GAY 63		■		40	50	100	300	80
GAY 64		■		80	90	75	225	80
GAZ 16		■		25		20	120	100
GAZ 17	■			25		20	120	100
GP 119			■	20		(3)		30
GP 120			■	20		(3)		30
GP 121			■	50		(3)		30
GP 122			■	50		(3)		30

▲ Nicht für Neuentwicklungen
■ In Entwicklung

▲ Не предназначено для новых разработок
■ В данный момент разрабатывается

▲ Not for new developments
■ Under developments

Ge-Universaldioden

Typ	U_F/V	bei I_F/mA	$I_R/\mu A$	bei U_R/V	$I_R/\mu A$	bei U_R/V	U_{R2}/V	I_{F2}/mA
GA 100	1	5	100	10	500	20	30	100
GA 101	1	3	40	10	400	40	55	100
GA 102	1	3	40	10	350	60	80	100
GA 103	1	3	15	10	250	80	100	100
GA 104	1	3	15	10	200	110	120	100
GA 105	1	3	100	10	500	20	30	100
GAZ 17	1	5	30	10				

Ge-Schaltdioden

Typ	U_T/V	bei I_T/mA	I_R/A	bei U_R/V	C_{100}/pF	bei U_R/V	f/MHz	I_0/mA bei $U_R = 0$
GA 106	1	6	40	10				
GA 107	1	5	8	10				
GAY 60	1	75	1000	20	1,5	1	1	75
GAY 61	0,7	75	1000	20	1,5	1	1	100
GAY 62	0,5	10	50	10	1,5	1	1	100
GAY 63	0,8	7,5	50	10	1,5	1	1	100
GAY 64	1	76	250	20	1,5	1	1	75
GAY 16	1	5	30	10				

Referenzelemente

Typ	U_{f}/V	r_{f}/Ω	$r_{\text{f,max}}/\Omega$	$\Delta U_{\text{f}}/\text{mV}$	P_{tot}/mW
SZY 20	$8,4 \pm 0,4$	15	25	≤ 66	100
SZY 21	$8,4 \pm 0,4$	15	25	≤ 33	
SZY 22	$8,4 \pm 0,4$	15	25	$\leq 13,2$	
SZY 23	$8,4 \pm 0,4$	15	25	$\leq 6,6$	

* In Durchlaßrichtung gepolte Diode

¹⁾ ohne Kühlblech

²⁾ mit Kühlblech Al 100 × 100 × 3 mm³

* Полюса диода, подключённые
в пропускном направлении

¹⁾ без листа для охлаждения

²⁾ с листом охлаждения алюм.
100 × 100 × 3 мм³

* Diode poled in forward direction

¹⁾ without cooling sheet

²⁾ wit cooling sheet Al 100 × 100 × 3 mm³

Ge-Gleichrichterdioden*

Typ	U_{RZ}/V	U_{R}/V	U_{RP}/V	$\bar{I}_{\text{RZ}}/\text{A}$	I_{RZ}/A	$I_{\text{R}}/\mu\text{A}$
GY 099	12	12	12	0,1	0,35	100
GY 100	24	24	24			100
GY 101	40	40	40			100
GY 102	75	75	75			100
GY 103	100	100	100			100
GY 104	150	150	150			50
GY 105	200	200	200			50
GY 109	12	12	12	1	3	200
GY 110	24	24	24			
GY 111	40	40	40			
GY 112	75	75	75			
GY 113	110	100	100			
GY 114	150	150	150			
GY 115	200	200	200			
GY 120	20	20	20	10	32	2000
GY 121	40	40	40			
GY 122	65	65	65			
GY 123	100	100	100			
GY 124	150	150	150			
GY 125	200	200	200			

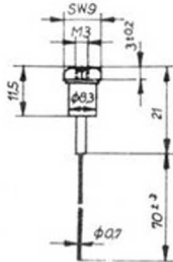
* Nicht für Neuentwicklungen

* Не предназначено для разработок

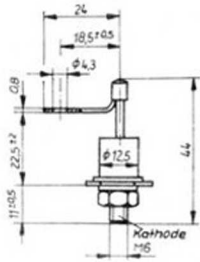
* Not for new developments



GY 099 - 105
Masse $\approx 0,6 \text{ g}$



GY 109 - 115
Masse $\approx 4 \text{ g}$



GY 120 - 125
Masse $\approx 23,5 \text{ g}$

Ge-Photodioden

Typ	$S_{T\text{H min}}/\mu\text{A}$	$S_{T\text{H max}}/\mu\text{A}$	bei U_{B}/V	$I_{\text{Dmin}}/\mu\text{A}$	$I_{\text{Dmax}}/\mu\text{A}$	A/mm^2
GP 119	30	70	20	7	15	1
GP 120	100	125	20	7	15	1
GP 121	30	70	50	7	15	1
GP 122	100	125	50	7	15	1

* bei 1000 x und einer Farbtemperatur der Strahlungsquelle von 2850 °K

* при 1000 x и цветовой температуре источника излучения 2850 °K

* at 1000 x and a colour temperature from the radiation source of 2850 °K

Übersicht Ge-Transistoren

Typ	Art			Anwendung, Frequenz						Grenzwerte				
	L	LD	ME	NF	AM	FM	VHF	UHF	Schalter	$-U_{CE0}/V$	$-U_{BE0}/V$	$-I_C/mA$	P_{tot}/W	$R_{th25}/\text{grd mW}^{-1}$
GC 100	■			■						15	10	15	0,03	1
GC 101	■									15	10	15	0,03	1
▲ GC 112	■			■						80	20	150		0,38
GC 116	■			■						20	10	150		0,38
GC 117	■			■						25	10	150		0,38
GC 118	■			■						25	10	150		0,38
● GC 121	■			■						25	10	250		0,38
GC 122	■			■						35	15	250		0,38
GC 123	■			■						70	15	250		0,38
● GC 301	■			■						32	10	1000	1	0,3
GF 126		■			■									
GF 128		■				■								
GF 130		■				■								
GF 131		■				■				25	0,5	10		0,6
GF 132		■				■								
GF 139		■				■								
GF 145			■					■						
■ GF 147			PI					■		20	0,3	10	0,06	0,75
GF 181		■				■				25	0,5	10		0,6
GF 100	■				■									
GF 105					■					15	10	15		0,5
● GD 160	■			■					■	20	10	3000	5,3	0,0075
● GD 170	■			■					■	33	10	3000	5,3	0,0075
● GD 175	■			■					■	50	10	3000	5,3	0,0075
● GD 180	■			■					■	66	10	3000	5,3	0,0075
● GD 240	■			■					■	40	10	3000	10	0,004
● GD 241	■			■					■	50	20	3000	10	0,004
● GD 242	■			■					■	50	20	3000	10	0,004
● GD 243	■			■					■	65	20	3000	10	0,004
● GD 244	■			■					■	75	20*	3000	10	0,004
GS 109	■			■					■	20	10	50		0,5
GS 111	■			■					■					
GS 112	■			■					■	20	10	200		0,5
GS 121	■			■					■	30	10	100		0,38
GS 122	■			■					■					

- ▲ Nicht für Neuentwicklungen
 ● Paarweise lieferbar
 ■ In Entwicklung

- ▲ Не предназначено для новых разработок
 ● Поставляется парами
 ■ В данный момент разрабатывается

- ▲ Not for new developments
 ● Available in pairs
 ■ Under development

- L Legierung
 LD Legierungsdiffusion
 ME Mesa
 PI Planar

- L Сплав
 LD Диффузия сплава
 ME Меза
 PI Планар

- L Alloy
 LD Alloy diffusion
 ME Mesa
 PI Planar

Ge-pnp-NF-Transistoren

Typ	$-I_{EBO}/\mu A$	bei $-U_{EB}/V$	$-I_{EBO}/\mu A$	bei $-U_{EB}/V$	h_{21e} (B)	bei $-U_{CE}/V$	$-I_C/mA$	f_T/MHz (f_β)	bei $-U_{CE}/V$	$-I_C/mA$	F/dB	$-U_{CE}/V$	$-I_C/mA$	R_e/Ω	f/kHz
GC 100	≤ 15	6	≤ 500	15				1	6	1	≤ 25	1	0,2	500	1
GC 101	≤ 15	6	≤ 500	15							≤ 10				
GC 112	≤ 18	15	≤ 50	10	≥ 10	6	2	$\geq 0,3$							
GC 116	≤ 18	15	≤ 50	10				$\geq 0,75$	6	2	≤ 20		0,3	500	1
GC 117	≤ 18	15						$\geq 1,2$			≤ 10	6			
GC 118	≤ 18	15						$\geq 1,2$			≤ 5				
GC 121	≤ 18	15	≤ 50		(28)			(0,012)							
GC 122	≤ 18	15	≤ 50	10	(18)	0,5	100	(0,012)	2	10					
GC 123	≤ 18	15	≤ 50		(18)			(0,012)							
GC 301	≤ 20 ≤ 250	6 32	≤ 50	10	(≥ 28)	1	350	(0,015)	2	10					

Ge-pnp-Schalttransistoren

Typ	$-I_{CBO}/\mu A$	bei $-U_{CE}/V$	$-U_{CEmax}/V$ ($-U_{CEmax}/V$)	$-I_C/mA$	bei $-I_B/mA$	$\tau_d/\mu s$	$-U_{CE}/V$	bei $-I_C/mA$	$t_s/\mu s$	$-I_C/mA$	bei I_B/mA	F/dB	$-U_{CE}/V$	bei $-I_C/mA$	f/kHz
GS 109	≤ 15		($\leq 0,5$)	50		$\leq 1,5$	0,5	50				≤ 25	1	1	1
GS 111	≤ 15	15	$\leq 0,3$			$\leq 1,2$			$\leq 1,5$						
GS 112	≤ 15		$\leq 0,3$	300	9,4	$\leq 0,9$	0,5	200	$\leq 1,5$	300	9%				
GS 121	≤ 15		($\leq 0,5$)			≤ 10	0,5	100				≤ 25			
GS 122	≤ 15	15	($\leq 0,5$)	100					≤ 25				1	1	1

Ge-pnp-HF-Transistoren

Typ	$-I_{CBO}/$ μA	bei $-U_{CB}/$ V	V_{BE}/dB (G_{BE}/dB)	bei $-U_{CB}/$ V	$-I_C/$ mA	f/MHz	V_{BE}/dB (F/dB)	$-U_{CB}/$ V	$-I_C/$ mA	f/MHz	f_T/MHz (V_{BE}/dB)	bei $-U_{CB}/$ V	$-I_C/$ mA	f/MHz
GF 100	≤ 10	6					(≤ 15)	6	0,5	0,5				
GF 105	≤ 10						(≤ 20)	6	0,5	2				
GF 126	$\leq 7,5$										≥ 40	6	1	0,5
GF 128	$\leq 7,5$										≥ 100	10	3	100
GF 130	$\leq 7,5$										($\geq 27,5$)	6	1	10
GF 131	$\leq 7,5$	6					≥ 9							
GF 181	$\leq 7,5$						≥ 11	7	1,5	100				
GF 132	$\leq 7,5$		≥ 17	6	2	100								
GF 139	$\leq 7,5$										($\geq 27,5$)	6	1	10
GF 145	≤ 8	20	(≥ 9)	12	1,5	800	(≤ 9)	12	1,5	800	≥ 250	12	1,5	100
GF 147	≤ 8	20	($\geq 11,5$)	12	2	800	(≤ 6)	10	2	800	≥ 650	10	2	100

Ge-pnp-Leistungstransistoren

Typ	$-I_{CBO}/\mu A$	bei $-U_{CE}/V$	I_{CEB}/mA	bei $-U_{CE}/V$	$I_{EB0}/\mu A$	bei $-U_{EB}/V$	$-U_{CEsat}/V$	$-I_C/A$	bei $-I_E/A$	f_T/kHz	$-U_{CE}/V$	bei $-I_C/mA$
GD 160	≤ 50	6	$\leq 1,5$	20	≤ 100	10	$\leq 0,6$	3	0,5	≤ 250	6	0,1
GD 170	≤ 50		≤ 1	33	≤ 100		$\leq 0,6$			≤ 250		
GD 175	≤ 50		≤ 1	50	≤ 100		$\leq 0,6$			≤ 250		
GD 180	≤ 50		≤ 1	66	≤ 100		$\leq 0,6$			≤ 250		
GD 240	≤ 100	6	≤ 4	30	≤ 500	10	$\leq 0,6$	3	0,5	≤ 350	6	0,1
GD 241	≤ 100		≤ 4	40	≤ 500		$\leq 0,6$			≤ 350		
GD 242	≤ 100		≤ 4	50	≤ 500	20	$\leq 0,6$			≤ 350		
GD 243	≤ 100		≤ 4	65	≤ 500		$\leq 0,6$			≤ 300		
GD 244	≤ 100		≤ 4	75	≤ 500		$\leq 0,6$			≤ 300		

Übersicht Si-Dioden

Typ	Art			Anwendung				Grenzwerte					
	Pl	Ep	P	Schalt- dioden	Kapa- zitäts- dioden	Varak- tor- dioden	Dioden- block	U_R/V (U_{RM}/V)	U_{RM}/V	I_F/mA	I_{RM}/mA	P_{tot}/mW (P_{is}/W)	$R_{th}/grad\ mW^{-1}$
■ SA 129		■			■			28	30				
■ SA 130		■			■			28	30				
■ SA 131		■			■			28	30				
SAZ 12		■			■			18				300	
SAZ 13		■			■			18				300	
■ SAZ 54		■				■		($\frac{1}{10}$ 90)				(6)	
■ SAZ 61		■				■		($\frac{1}{10}$ 90)				(1,5)	
SAY 10		■		■				50	60	175	350	300	m 0,35
SAY 11		■		■				25	35	115	225	300	m 0,35
■ SAY 12		■		■				50	75	300	600	430	m 0,3
SAY 14		■		■				25	35	115	225	300	m 0,35
SAY 15		■		■				15	20	75	150	300	m 0,35
■ SAY 16		■		■				30	35	300	600	430	m 0,3
SAY 40	■		■	■				15	20	20	40	150	m 0,5
SAY 42	■		■	■				15	20	30	60	150	m 0,5
SAY 60	■		■	■				15	20	20	40	150	m 0,5
SAY 62	■		■	■				15	20	30	60	150	m 0,5
SAM 42...45	■		■	■			■	15	20	20	40	150	m 0,5
SAM 62...65	■		■	■			■	15	20	20	30	150	m 0,5
SAX 42...46 ¹⁾	■		■	■			■	15	20	20	40	150	m 0,5
SAX 62...66 ²⁾	■		■	■			■	15	20	30	60	150	m 0,5

¹⁾ 2...6 Stück SAY 40

²⁾ 2...6 Stück SAY 42

Pl Planar

Ep Planar-Epitaxie

P Plastverkappt

Pl Планар

Ep Эпитаксия планара

P Под пластмассовым колпачком

Pl Planar

Ep Planar epitaxy

P plastic covered

Si-Schaltdioden

Typ	I_0/mA	I_R/nA	bei U_R/V	C_{tot}/pF	U_R/V	bei U_{RF}/mV	f/MHz	t_{rr}/ns	beim Schalter von $I_F = 10\text{mA}$ auf $U_R = 6\text{V}$
SAY 10	115	50	50	3				2	
SAY 11	75	70	25	4				2	
SAY 12	200	100	50	4	0	50	1	4	
SAY 14	75	70	25	4				4	
SAY 15	50	500	20	4				4	
SAY 16	200	100	30	4				4	
SAY 40		60	15	8				10	
					0		0,5		
SAY 42		60	15	8				10	
SAY 60*		60	15	8				10	
					0		0,5		
SAY 62*		60	15	8				10	

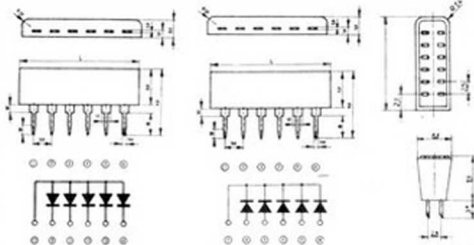
* Doppeldioden-Kennwerte pro Diode

* Технические данные двойного диода на каждый диод

* Double diode performance indices per diode

Si-Mehrfachdioden

SAM 42...45	2...5 Diodenfunktionen SAY 40 mit gemeinsamer Katode
SAM 62...65	2...5 Diodenfunktionen SAY 40 mit gemeinsamer Anode
SAX 42...46	Zusammenfassung von 2 bis 6 Einzeldioden SAY 40
SAX 62...66	Zusammenfassung von 2 bis 6 Einzeldioden SAY 42



SAX 42 - 46
SAX 62 - 66

	$\frac{l}{\text{mm}}$	$\frac{m}{\text{g}}$
SAM 62	9	0,3
SAM 63	11,5	0,4
SAM 64	14	0,4
SAM 65	16,5	0,5

	$\frac{l}{\text{mm}}$	$\frac{m}{\text{g}}$
SAM 42	9	0,3
SAM 43	11,5	0,4
SAM 44	14	0,4
SAM 45	16,5	0,5

Maße für „J“	mm
2fach Diode	7,0
3fach Diode	9,6
4fach Diode	12,1
5fach Diode	14,7
6fach Diode	17,2

Si-Gleichrichterdioden

Typ	U_{RR}/V	U_R/V	U_{RR}/V	U_{RR}/V	I_{RM}/A	I_{RM}/A	I_R/mA
für Ströme bis zu 1 A							
SY 200; SY 220	75	75	100	100	0,7*	2	0,15
SY 201; SY 221	100	100	130	150			
SY 202; SY 222	200	200	260	300			
SY 203; SY 223	300	300	390	450			
SY 204; SY 224	400	400	520	600			
SY 205; SY 225	500	500	650	750			
SY 206; SY 226	600	600	780	900			
SY 207; SY 227	700	700	910	1050			
SY 208; SY 228	800	800	1040	1200			
SY 210; SY 230	1000	1000	1300	1500			
SY 200 - 210 ¹⁾ SY 220 - 230 ¹⁾							
* bei R-Last							

für Ströme bis zu 10 A

SY 160	50	50	55	75	30	≤ 3
SY 162	200	200	220	300		
SY 164	400	400	440	600		
SY 166	600	600	660	900		

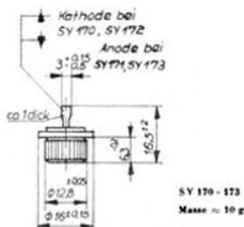
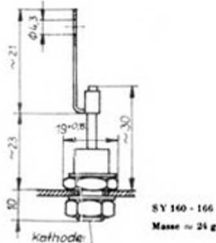
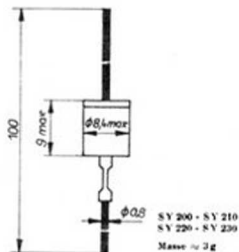
für spezielle Anwendungen in der Kfz.-Technik

SY 170 ¹⁾	100	100	25	39	8 8 6 6
SY 171 ¹⁾	100	100			
SY 172 ¹⁾	200	200			
SY 173 ¹⁾	200	200			

¹⁾ Anode am Gehäuse
²⁾ Kathode am Gehäuse

¹⁾ Анод на корпусе
²⁾ Катод на корпусе

¹⁾ Anode on housing
²⁾ Cathode on housing



Si-Leistungsgleichrichterdioden

	U_{RS}/V	U_R/V	U_{RP}/V	U_{RS}/V	I_{TR}/A	I_{TP}/A	I_R/mA
VSF 200/0,5*	50	50	55	90	200	800	≤ 10
VSF 200/1*	100	100	110	180			
VSF 200/2*	200	200	220	360			
VSF 200/3*	300	300	330	540			
VSF 200/4*	400	400	440	720			
VSF 200/5*	500	500	550	900			
VSF 200/6*	600	600	660	1080	$\bar{I}_{TR}/A$	1200	≤ 7
VSF 203/0,5	50	50	75	90			
VSF 203/1	100	100	150	180			
VSF 203/2	200	200	300	360			
VSF 203/3	300	300	450	540			
VSF 203/4	400	400	600	720			
VSF 203/5	500	500	750	900			
VSF 203/6	600	600	900	1100			

* Nicht für Neuentwicklungen

* Не предназначено для новых разработок

* Not for new developments

Si-Z-Dioden

Typ	U_A/V bei $I_A = 5\text{ mA}$	r_A/Ω bei $I_A = 5\text{ mA}$	U_A/V bei $I_A = 1\mu A$	U_F/V bei $I_F = 5\text{ mA}$	P_{tot}/mW
Reihe E 12 (10%)					
SZX 18/1	0,65 < 0,75 < 0,85	8	—	0,85	250
SZX 18/5,6	5,0 < 5,6 < 6,3	65	1		
SZX 18/6,8	6,0 < 6,8 < 7,5	10	2		
SZX 18/8,2	7,3 < 8,2 < 9,2	8	3,5		
SZX 18/10	8,8 < 10 < 11,0	17	5		
SZX 18/12	10,7 < 12 < 13,4	30	7		
SZX 18/15	13,0 < 15 < 16,5	40	10		
SZX 18/18	16,0 < 18 < 20,0	55	10		
SZX 18/22	19,6 < 22 < 24,4	90	12		

Reihe E 24 (5%)

SZX 19/5,1	4,8 < 5,1 < 5,4	75	1	0,85	250
SZX 19/5,6	5,2 < 5,6 < 6,0	60	1		
SZX 19/6,2	5,8 < 6,2 < 6,6	35	1		
SZX 19/6,8	6,4 < 6,8 < 7,2	8	2		
SZX 19/7,5	7,0 < 7,5 < 7,9	7	2		
SZX 19/8,2	7,7 < 8,2 < 8,7	7	3,5		
SZX 19/9,1	8,5 < 9,1 < 9,6	10	3,6		
SZX 19/10	9,4 < 10 < 10,6	15	5		
SZX 19/11	10,4 < 11 < 11,6	20	5		
SZX 19/12	11,4 < 12 < 12,8	20	7	0,85	250
SZX 19/13	12,5 < 13 < 14,0	30	7		
SZX 19/15	13,8 < 15 < 15,5	35	10		
SZX 19/16	15,3 < 16 < 17,0	40	10		
SZX 19/18	16,8 < 18 < 19,0	50	10		
SZX 19/20	18,8 < 20 < 21,0	80	10		
SZX 19/22	20,8 < 22 < 23,0	80	12		
SZX 19/24	22,8 < 24 < 25,6	80	12		



Si-Kapazitätsdioden

Typ	$I_{\text{R}}/\mu\text{A}$	bei U_{R}/V	C_{J}/pF	bei U_{R}/V	r_{J}/Ω	C_{C}/pF	L_{C}/nH	f_{J}/GHz
SA 129	≤ 5	28	12 2,2...3,2	3 25	0,5			$> 1,45$
SA 130	≤ 5	28	9 ...16 2,2...3,2	3 25	1			$> 1,45$
SA 131	≤ 5	28	45...65	2	0,5			
SAZ 12	≤ 10	18	1 ...5	6		0,4	3,5	
SAZ 13	≤ 10	18	1 ...5	6		0,4	3,5	

Übersicht Si-Transistoren

Typ	Art				Anwendung		Grenzwerte				
	Pl	Ep	MOS	P	NF	HF	U_{CE0}/V	U_{EBO}/V	I_C/mA	P_{tot}/mW	$R_{thJA}/\text{grad } mW^{-1}$
SC 206	■			■	■		20	5	100	200	$\leq 0,5$
SC 207	■			■	■		20	5	100	200	$\leq 0,5$
▲ SF 021		■				■	20	5	500	600	$\leq 0,25$
▲ SF 022		■				■	33	5	500	600	$\leq 0,25$
▲ SF 023		■				■	66	5	500	600	$\leq 0,25$
▲ SF 024		■				■	100	5	500	600	$\leq 0,25$
▲ SF 025		■				■	120	5	500	600	$\leq 0,25$
SF 121	■					■	20	5	100	600	$\leq 0,25$
SF 122	■					■	33	5	100	600	$\leq 0,25$
SF 123	■					■	66	5	100	600	$\leq 0,25$
SF 126		■				■	33	7	500	600	$\leq 0,25$
SF 127		■				■	66	7	500	600	$\leq 0,25$
SF 128		■				■	100	7	500	600	$\leq 0,25$
SF 129		■				■	120	7	500	600	$\leq 0,25$
SF 131	■					■	20	5	50	300	$\leq 0,5$
SF 132	■					■	40	5	50	300	$\leq 0,5$
SF 136		■				■	20	5	200	300	$\leq 0,5$
SF 137		■				■	40	5	200	300	$\leq 0,5$
■ SF 150	■				■		140	5	50		
SF 215	■			■		■	20	5	100	200	$\leq 0,5$
SF 216	■			■		■	40	5	100	200	$\leq 0,5$
■ SF 240	■			■		■	40	4	25		
■ SF 245		■		■		■	40	4	25		
Schalter											
mittel schnell											
SS 106		■				□	25	5	200	300	$\leq 0,5$
SS 108		■				□	40	5	200	300	$\leq 0,5$
SS 109		■				□	20	5	200	300	$\leq 0,5$
■ SS 120		■				□	60	5	500	700	
▲ SS 125		■			□		30	5	500	600	$\leq 0,25$
▲ SS 126		■			□		60	5	500	600	$\leq 0,25$
SS 200	■			■	□		70	5	30	150	$\leq 0,5$
SS 201	■			■	□		100	5	30	150	$\leq 0,5$
SS 202	■			■	□		120	5	30	150	$\leq 0,5$
SS 216		■		■		□	20	5	100	200	$\leq 0,5$
SS 218		■		■		□	20	5	100	200	$\leq 0,5$
■ SS 219		■		■		□	20	5	100	200	$\leq 0,5$
							U_{DS}/V	U_{GS}/V	I_D/mA	P_{tot}/mW	$R_{thJA}/\text{grad } mW^{-1}$
■ SM 103			■	■			20	-15 ... +5	15	150	$\leq 0,6$
■ SM 104			■	■			20	-15 ... +5	15	150	$\leq 0,6$

- ▲ Nicht für Neuentwicklungen
 ● Paarweise lieferbar
 ■ In Entwicklung

- ▲ Не предназначено для новых разработок
 ● Поставляется парами
 ■ В данный момент разрабатывается

- ▲ Not for new developments
 ● Available in pairs
 ■ Under development

- Pl Planar
 Ep Planar-Epitaxie
 MOS MOSFET
 P Plastikverpackt
 NF Planar
 HF Зигзаг планара
 MOS МОСФЕТ
 P Под пластмассовым колпачком
 Pl Planar
 Ep Planar epitaxy
 MOS MOSFET
 P plastic covered

Si-npn-Schalttransistoren

Typ	$I_{CBO}/$ nA	bei $U_{CE}/$ V	$U_{CE,sat}/$ V	bei $I_C/$ mA	$I_B/$ mA	$t_{on}/$ ns	$t_{off}/$ ns	$I_C/$ mA	$I_{B1}/$ mA	bei $-I_{B2}/$ mA	R_L/Ω	f_T/MHz	bei $U_{CE}/$ V	$I_C/$ mA	f/MHz
SS 106	≤ 50	15	$\leq 0,5$	10	1	≤ 40	≤ 75					≤ 200			
SS 108	≤ 50	20	$\leq 0,5$	10	1	≤ 40	≤ 75	10	3	1,5	270	≤ 300	10	10	100
SS 109	≤ 50	15	$\leq 0,5$	100	10	≤ 40	≤ 75					≤ 200			
SS 120			≤ 1	500	50	≤ 50	≤ 100	500							
SS 125	≤ 25	20										≤ 30			
SS 126	≤ 25	40										≤ 30	12	50	15
SS 216	≤ 300	20	$\leq 0,45$	30	3	≤ 35	≤ 30	10	3	1,5	270				
SS 218	≤ 300		$\leq 0,45$												
SS 219	≤ 300		$\leq 0,45$			≤ 35	≤ 30								

Si-npn-Spezialtransistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigertönen

Typ	$I_{CEV}/\mu A$	bei U_{CEV}/V	I_{EBO}/V	bei U_{EB}/V	U_{CEsat}/V	bei I_C/mA	I_E/mA	β	U_{CE}/V	bei I_C/mA
SS 200	≤ 1	70	≤ 100		≤ 3 $\leq 0,6$			≥ 32		
SS 201	≤ 1	100	≤ 100	5	≤ 3 $\leq 0,6$	10	0,31	≥ 32	3	10
SS 202	≤ 1	120	≤ 100		≤ 3 $\leq 0,6$	1	0,031	≥ 32		

Si-npn-HF-Transistoren

Typ	$I_{CBO}/$ nA	bei $U_{CB}/$ V	$U_{CEsat}/$ V	bei $I_C/$ mA	$I_B/$ mA	$f_T/$ MHz	$U_{CE}/$ V	$I_C/$ mA	bei $f/$ MHz	$C_{in}/$ pF	$U_{CB}/$ V	$I_B/$ mA	bei $f/$ MHz	$V_{sw}/$ dB	bei $U_{CE}/$ V	$I_C/$ mA	$f/$ MHz
SF 021	1000	20	1			60											
SF 022	100	33	1			60											
SF 023	100	66	1	50	5	60	10	10	15								
SF 024	100	100	1			60											
SF 025	100	120	1			60											
SF 121	1000	20	1			60											
SF 122	1000	33	1	50	5	60	1	10	15								
SF 123	1000	66	1			60											
SF 126	100	33	0,5			60				20							
SF 127	100	66	0,5			60				20							
SF 128	100	100	0,5	150	15	60	10	10	15	20	10	0	2				
SF 129	25	80	0,5			60				20							
SF 131	100	20	0,5			200				5							
SF 132	100	40	0,5	10	1	200	10	10	100	5	10	0	2				
SF 136	100	20	0,3			300				5							
SF 137	100	40	0,3	10	1	300	10	10	100	5	10	0	2				
SF 150			5	30	6	80	10	10	50	5	10	10	50				
SF 215	100													4	8	1	100
SF 216	100	20															
SF 240						440								24	10	4	36
SF 245						780	10	7	100					28	10	7	36

Si-n-Kanal-MOS-Transistoren

Typ	$ y_{ms} /mS$	U_{DS}/V	bei U_{GS}/V	f/kHz	R_s/Ω	bei U_{DS}/V	I_D/mA	bei U_{DS}/V	U_{GS}/V	$-U_T/V$	bei $I_D/\mu A$	U_{DS}/V
SM 103	$\approx 1,3$	8	0	1	$\leq 10^{11}$	10	≤ 12	8	0	12	10	8
SM 104	$\approx 1,0$	8	0	1	$\leq 10^{11}$	10	$\leq 6,5$	8	0	8	10	8

Si-Thyristoren*

Typ	U_{KW}/V	$U_{RR}/V^{(1)}$	I_T/A	I_{TR}/A	U_{GT}/V	I_{GT}/mA
ST 111/1	70	100	13	90	$\leq 3 V$ bei 25° C und 12 V Blockier- spannung	≤ 100
ST 111/2	140	200				
ST 111/4	280	400				
ST 111/6	420	600				
ST 111/8	560	800				
ST 121/1	70	100	23	140	$\leq 3 V$	≤ 100
ST 121/2	140	200				
ST 121/4	280	400				
ST 121/6	420	600				
ST 121/8	560	800				

* In Entwicklung

¹⁾ max. Dauer der periodischen Spitzenspannung 1 ms
max. Dauer der nichtperiodischen Spitzenspannung 5 ms

* В данный момент разрабатывается

¹⁾ наибольшее время периодического максимального напряжения 1 мсек
наибольшее время непериодического максимального напряжения
5 мсек

* Under development

¹⁾ maximum duration of periodical peak voltage 1 ms
max. duration of non-periodical peak voltage 5 ms